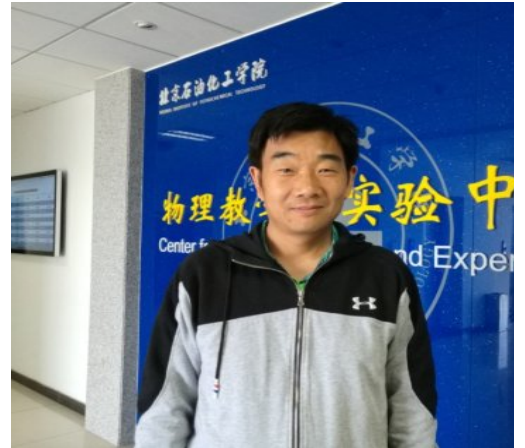


教师风采

数学教研室教师
物理教学与实验中心教师
信息与计算科学教研室教师

李东临

发布日期: 2018-09-14



一、基本情况

李东临，男，1967年10月生，山东临沂人。北京石油化工学院副教授。

教育经历：1989年7月毕业于山东大学物理系，获理学学士学位；1995年7月毕业于北京师范大学物理系凝聚态物理专业，获理学硕士学位；2003年9月到中科院半导体所学习，于2006年7月毕业，获材料物理与化学专业博士学位。主要研究方向为化合物半导体材料的输运性质以及半导体微电子和光电子器件性能研究。

科研情况：研究领域的工作主要在III—V族化合物半导体的材料生长和器件性能方面。研究了InAlAs/InGaAs/InP HEMT中二维电子气的性质以及对材料和器件输运性能的影响，利用数值计算的方法系统研究了单边掺杂和双掺杂HEMT器件的性能与结构参数之间的关系，分析影响材料输运性能的各项散射机制。通过Hall测试和SdH振荡测试等实验手段从实验角度对材料进行了进一步分析，取得了一系列具有创新性的研究成果，发表SCI、EI及核心期刊文章数篇。

二、主讲课程

理工科学生《大学物理A一》，《大学物理A二》和《大学物理实验上》、《大学物理实验下》课程，同时合作主讲选修课《物理前沿知识讲座》，《大学物理补充与提高》。教学效果良好。

三、科研论文

1、含InAs夹层的复合沟道InP基HEMT材料电子输运特性研究

第六届国际纳米学术研讨会。 2007. 10

2、利用自洽计算研究InP基HEMT器件的材料性能

北京石油化工学院学报 2008. 6

3、InP基HEMT的自洽计算模型

第十三届全国化合物半导体材料、微波器件和光电器件

4、InP基HEMT器件中二维电子气浓度及分布与沟道层厚度关系的理论分析 物理学报 2006. 7

5、Self-consistent analysis of double-delta-doped InAlAs/InGaAs/InP HEMTs Chinese Physics 2006. 9

四、业余爱好：羽毛球，长跑